

表面科学会第2回関東支部講演会
ポスター講演プログラム

- P-01 ワイル半金属の特異な電磁応答 ～バルク伝搬波の存在の理論予測～
東理大総研院¹, 東理大工², 東理大理³, 産総研⁴, JST-CREST⁵
小鍋哲^{1,2}, 土川航太^{3,4}, 山本貴博^{1,2}, 川畑史郎^{4,5}
- P-02 フォトルミネッセンスを用いた DNA の塩基配列に依存した SWNT 表面への吸着の評価
東理大工¹, 東理大理², 東理大総研院³
伊藤雅浩¹, 山洞絵理², 本間芳和², 山本貴博^{1,3}
- P-03 強誘電分極によるグラフェンへのキャリア注入に関する第一原理シミュレーション
東理大工¹, 東理大総研院²
掘井耀¹, 小鍋哲^{1,2}, 山本貴博^{1,2}
- P-04 金属カーボンナノチューブにおける準バリスティック伝導の数値解析シミュレーション
東理大工¹, 東理大総研院², 神戸大工³,
石関圭輔¹, 笹岡健二², 小鍋哲^{1,2}, 相馬聡文³, 山本貴博^{1,2}
- P-05 CNT 薄膜の電気伝導シミュレーションと導電性の最適化
東理大工¹, 東理大総研院²
佃将明¹, 山本貴博^{1,2}
- P-06 Sn の自己凝集作用を用いたテクスチャ SnO₂ 透明導電膜の作製
東大院理¹, KAST²
福本通孝¹, 中尾祥一郎², 廣瀬靖^{1,2}, 長谷川哲也^{1,2}
- P-07 低入射電圧高空間分解能走査電子顕微鏡法における低エネルギー特性 X 線の検出
日本電子株式会社¹, 奈良工業高等専門学校², オックスフォード・インストゥルメンツ
株式会社³
山本康晶¹, 山田裕久², 森田博文³, 高橋秀之¹, 高倉優¹, 菊地真樹¹, 朝比奈俊輔¹

- P-08 グラフェンナノリボンを用いた電界効果トランジスタにおけるエッジ乱れの影響
東理大工¹, 東理大総研院²
高島健悟¹, 山本貴博^{1,2}
- P-09 全反射高速陽電子回折(TRHEPD)の方位角プロットによる表面構造解析の試み
KEK 物構研¹, 原子力機構先端基礎²
望月出海¹, 深谷有喜², 一宮彪彦¹, 兵頭俊夫¹
- P-10 独立4探針STMを用いた水素終端SrTiO₃表面の輸送特性のin situ評価
東大理¹, KEK 物構研², 東大物性研³
武内康範¹, 秋山了太¹, 保原麗¹, 一ノ倉聖¹, 湯川龍², 松田巖³, 長谷川修司¹
- P-11 印加電圧値を変化させた積層型セラミックコンデンサ断面のヘリウムイオン顕微鏡を用いた二次電子像観察
物材機構
酒井智香子, 石田暢之, 永野聖子, 大西桂子, 藤田大介
- P-12 単原子層超伝導体Si(111)- $\sqrt{3}\times\sqrt{3}$ -(Tl, Pb)のSTM/STS観察
東大理¹, Univ. of Hamburg², IACP FEB RAS³, FEFU⁴, VSUES⁵, 東大物性研⁶
中村友謙¹, H. Kim², 一ノ倉聖¹, 高山あかり¹, A. A. Saranin^{3,4}, A. Z. Zotov^{3,4,5},
長谷川幸雄⁶, 長谷川修司¹
- P-13 低温パラジウムへの水素イオン照射による準安定状態の実現
東大生研
小澤孝拓, 大野哲, 河内泰三, 小倉正平, 福谷克之
- P-14 アナターゼ型二酸化チタンにおける水素の拡散
東大生研
長塚直樹, Wilde Markus, 福谷克之
- P-15 二光子光電子分光の開発
東大生研
大橋由季, 長塚直樹, 櫻井敦教, 森近一貴, 芦原聡, 福谷克之

- P-16 3D Analysis of Stress Dynamics in Si(100) by Confocal Raman Microscopy
NIMS
Hongxin Wang, Han Zhang, Bo Da, and Daisuke Fujita
- P-17 超低入射電圧走査電子顕微鏡法によるナノ構造材料の表面観察
日本電子株式会社¹, 山形大²
作田裕介^{1,2}, 朝比奈俊輔¹, 石崎学², 富樫貴成², 栗原正人²
- P-18 ルチル型二酸化ルテニウム薄膜における電気輸送特性の膜厚依存性
東大院理¹, 東北大院理², KAST³
杵澤大^{1,2}, 岡大地², 福村知昭², 長谷川哲也^{1,3}
- P-19 水素吸着による Fe₃O₄(111)表面の電子状態制御
東大生研
浅川寛太, 長塚直樹, 福谷克之
- P-20 Epitaxial growth of baddeleyite NbON thin film on YSZ (100) substrate using self seed layer
Univ. of Tokyo¹, KAST²
Vitchaphol Motaneeyachart¹, Yasushi Hirose^{1,2}, Atsushi Suzuki¹, Shoichiro Nakao²,
Tetsuya Hasegawa^{1,2}
- P-21 単相遷移金属水素化物薄膜のエピタキシャル成長とその評価
東工大物質理工¹, 東北大 AIMR², 日工大工³, 東北大金研⁴
笹原悠輝¹, 清水亮太¹, 杉山一生¹, 大口裕之², 白木将³, 折茂慎一^{2,4}, 一杉太郎¹
- P-22 中性子反射率測定による LiCoO₂ 正極/固体電解質界面の Li 分布の解析
東工大物質理工¹, CROSS 東海², JAEA³
小林成¹, 杉山一生¹, 清水亮太¹, 花島隆泰², 宮田登², 武田全康³, 一杉太郎¹
- P-23 Nd:YAG 固体レーザーの 5 倍波(波長 213nm)を用いたパルスレーザー堆積
東工大物質理工
中村直人, 杉山一生, 清水亮太, 一杉太郎

P-24 トポタクティックフッ素導入/酸素アニールによる NdNiO₃ 薄膜の可逆的抵抗制御

東大院理¹, KAST², UTTAC³, JASRI⁴, KEK-PF⁵

小野塚智也¹, 近松彰¹, 片山司¹, 廣瀬靖^{1,2}, 原山勲³, 関場大一郎³, 池永英司⁴,
蓑原誠人⁵, 組頭広志⁵, 長谷川哲也^{1,2}